

2SB910M 2SB1238

エピタキシャルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ
中電力増幅用/Medium Power Amp.
Epitaxial Planar PNP Silicon Transistors

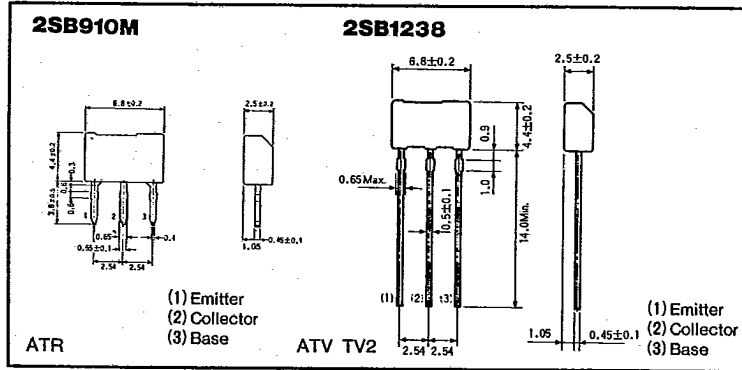
● 特長

- 1) $P_C=1W$ と大きい。
- 2) 高耐圧, 大電流である。
 $V_{CE0}=-80V, I_C=-0.7A$
- 3) 2SD1226M/2SD1859とコンプリ。

● Features

- 1) High power: $P_C=1W$.
- 2) High breakdown voltage and large current capacity.
 $V_{CE0}=-80V, I_C=-0.7A$
- 3) Complementary pair with 2SD1226M, 2SD1859.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit: mm)



注: ATVの外形仕様については, TV3/4/6タイプも用意しています (p.38参照)。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a=25^{\circ}C$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	-80	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5	V
コレクタ電流	I_C	-700	mA
コレクタ損失	P_C	1	W*
接合部温度	T_J	150	$^{\circ}C$
保存温度範囲	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}C$

* プリント基板:
コレクタ部分の銅箔面積 $1cm^2$ 以上,
厚み1.7mm

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a=25^{\circ}C$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV_{CEO}	-80	-	-	V	$I_C=-2mA$
コレクタ・ベース降伏電圧	BV_{CBO}	-80	-	-	V	$I_C=-50\mu A$
エミッタ・ベース降伏電圧	BV_{EBO}	-5	-	-	V	$I_E=-50\mu A$
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	-	-	-0.5	μA	$V_{CB}=-50V$
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	-	-	-0.5	μA	$V_{EB}=-4V$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	-	-0.2	-0.4	V	$I_C/I_E=-500mA/-50mA$
直流電流増幅率	h_{FE}	82	-	390	-	$V_{CE}/I_C=3V/-100mA$
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	f_T	-	100	-	MHz	$V_{CE}=-10V, I_E=50mA$
出力容量	C_{ob}	-	14	20	pF	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$

h_{FE} の値により下表のように分類します。

Item	P	Q	R
h_{FE}	82~180	120~270	180~390

● 標準品・準標準品一覧表

(◎:標準品 ○:準標準品)

Type	h_{FE}	包装名 記号 基本発注単位(個)	バルク	コンテナ	テーピング	
			1 000	4 000	2 500	2 500
2SB910M	PQR		◎	◎	-	-
2SB1238	PQR		-	-	◎	○

● 電氣的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

T-27-21

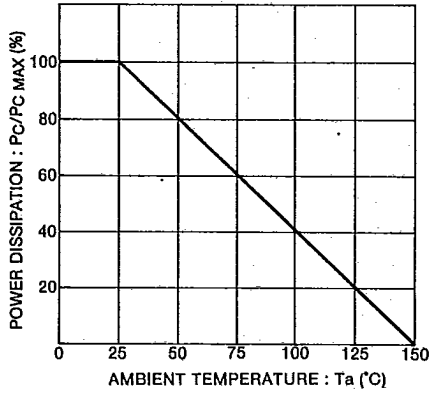


Fig.1 電力軽減曲線

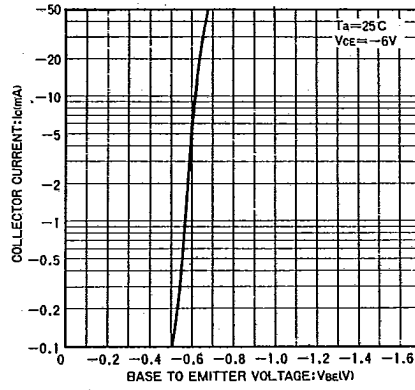


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

トランジスタ
2SB910M

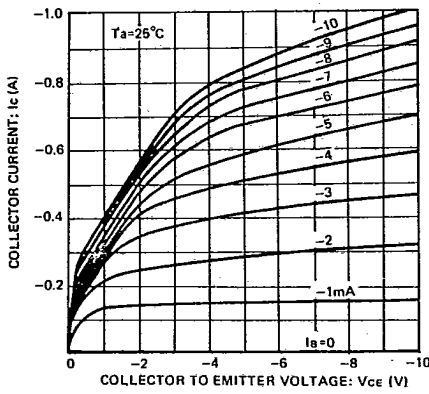


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

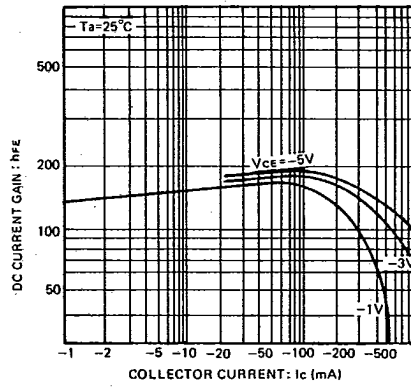


Fig.4 直流電流増幅率—コレクタ電流特性

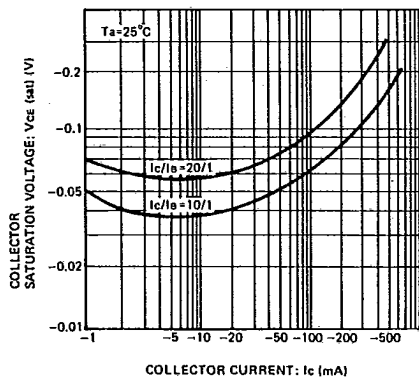


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性

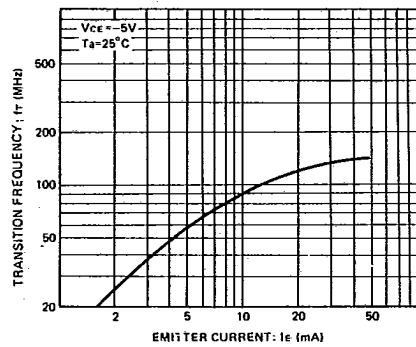


Fig.6 利得帯域幅積—エミッタ電流特性

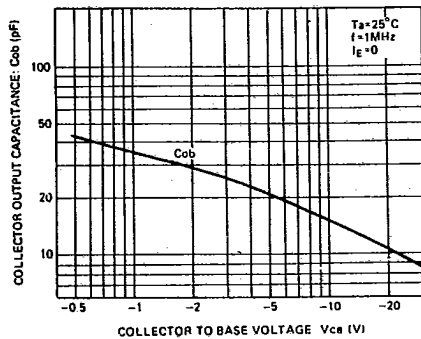


Fig.7 コレクタ出力容量—コレクタ・ベース電圧特性

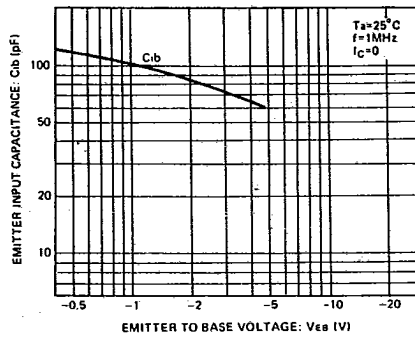


Fig.8 エミッタ入力容量—エミッタ・ベース電圧特性